



2SD412

TN-5236
MAY-30-75

NPNエピタキシャルメサ形 シリコントランジスタ(ダーリントン接続)
低周波電力増幅および低速度スイッチング
通信工業用

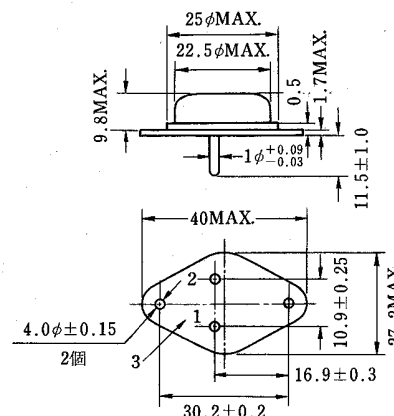
- ダーリントン接続であるため直流電流増幅率が高い。
- コレクタ飽和電圧が低い。
- パルスモータドライバ、リレードライバ等にICの出力から直接ドライブする用途に最適です。

絶対最大定格/Absolute Maximum Ratings ($T_a=25^\circ\text{C}$)

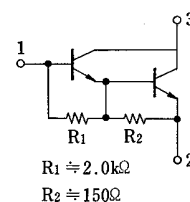
項 目	略 号	定 格	単 位
コレクタ・ベーク間電圧	V_{CBO}	150	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CEO}	100	V
エミッタ・ベース間電圧	V_{EBO}	10	V
コレクタ電流	$I_{C(DC)}$	15	A
コレクタ電流	$I_{C(pulse)^*}$	20	A
ベース電流	$I_{B(DC)}$	1.5	A
全 損 失 ($T_C=25^\circ\text{C}$)	P_T	100	W
コレクタしゃ断電流	T_j	150	$^\circ\text{C}$
保 存 温 度	T_{stg}	$-65\sim+150$	$^\circ\text{C}$

* $PW \leq 10\text{ms}$, duty cycle $\leq 50\%$

外形図/Outline (Unit: mm)



電極接続



1. Base
2. Emitter
3. Collector (Case)

EIAJ : TC-3, TB-3
JEDEC : TO-3
IEC : C14A, B18

$R_1 \cong 2.0\text{k}\Omega$
 $R_2 \cong 150\Omega$

電気的特性/Electrical Characteristics ($T_a=25^\circ\text{C}$)

項 目	略 号	条 件	MIN.	TYP.	MAX.	単 位
コレクタしゃ断電流	I_{CBO}	$V_{CB}=100\text{V}$, $I_E=0$			100	μA
直流電流増幅率	h_{FE}	$V_{CE}=2.0\text{V}$, $I_C=15\text{A}$ *	1000	4000		
コレクタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C=15\text{A}$, $I_B=30\text{mA}$ *			1.5	V
ベース飽和電圧	$V_{BE(sat)}$	$I_C=15\text{A}$, $I_B=30\text{mA}$ *			2.2	V

* パルス測定/pulsed $PW=350\mu\text{s}$, duty cycle $\leq 2\%$